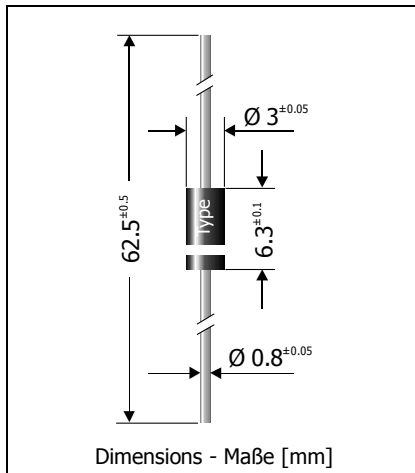


1N5059 ... 1N5062

Silicon Rectifier Diodes – Silizium-Gleichrichterdioden

Version 2005-09-20



| | |
|---|-------------------|
| Nominal current Nennstrom | 2 A |
| Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung | 200...800 V |
| Plastic case Kunststoffgehäuse | DO-15 DO-204AC |
| Weight approx. Gewicht ca. | 0.4 g |
| Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert | |
| Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack | |



Maximum ratings

Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| 1N5059 | 200 | 200 |
| 1N5060 | 400 | 400 |
| 1N5061 | 600 | 600 |
| 1N5062 | 800 | 800 |

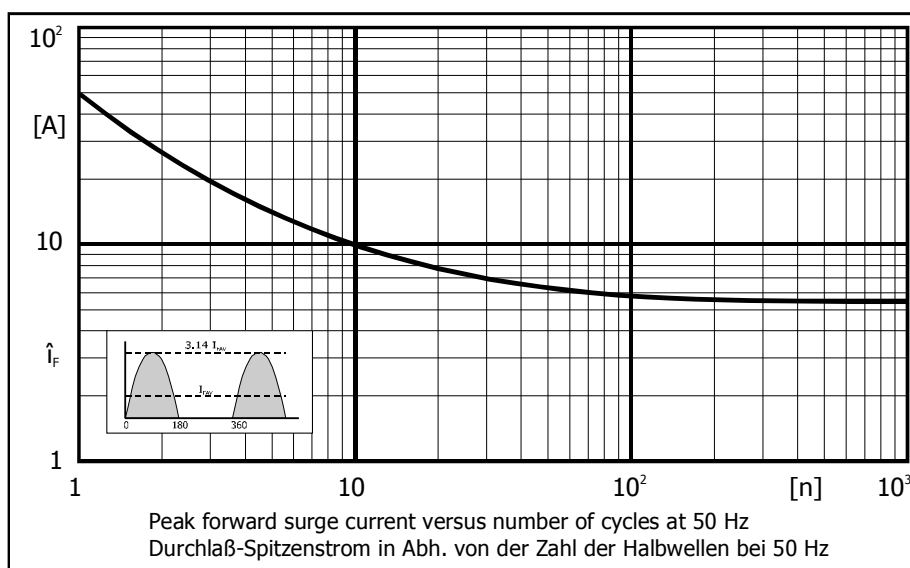
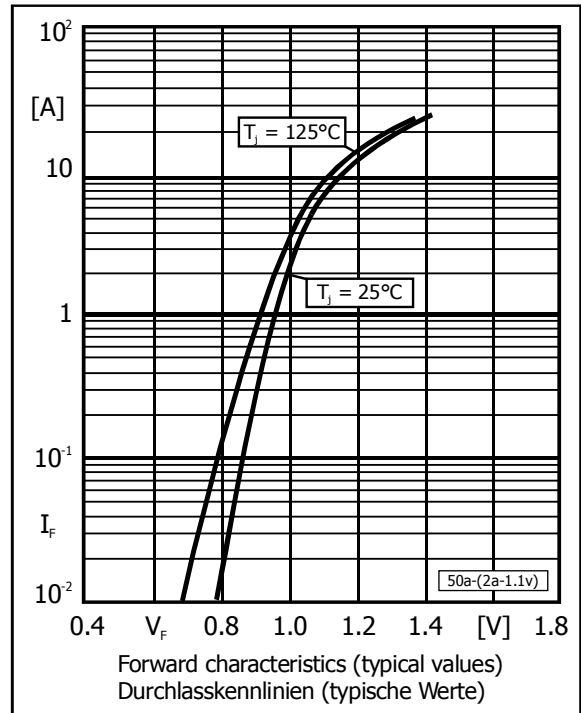
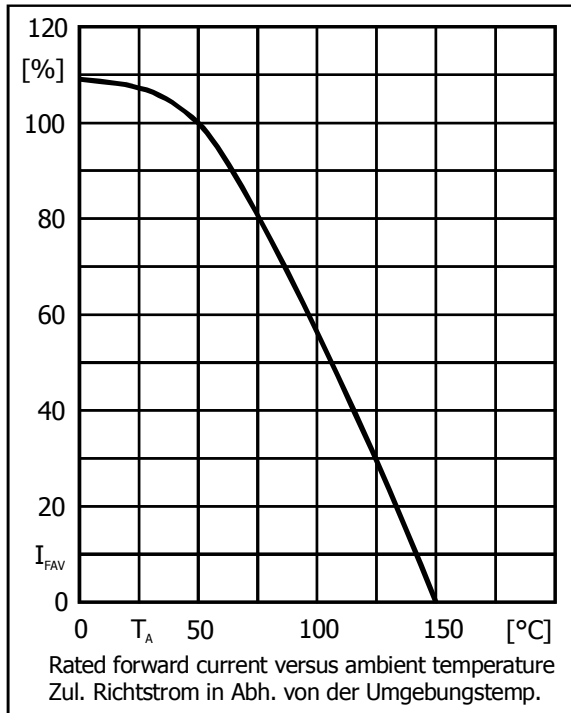
| | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last | $T_A = 50^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 2 A ¹⁾ |
| Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom | $f > 15\text{ Hz}$ | I_{FRM} | 10 A ¹⁾ |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FSM} | 50/55 A |
| Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$ | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | i^2t | 12.5 A ² s |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_j T_s | -50...+150°C -50...+175°C |

¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

Kennwerte

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------------|
| Forward voltage – Durchlass-Spannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $I_F = 2\text{ A}$ | V_F | < 1.1 V | |
| Leakage current – Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$ | I_R | < 5 μA | |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft | | | | R_{thA} | < 45 K/W ¹⁾ |
| resiThermalstance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss | | | | R_{thT} | < 15 K/W |



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden